

DRAM NHANH NHẤT THẾ GIỚI ĐẠT TỐC ĐỘ 800 MHZ

Sản ph

Sản phẩm mà hãng bán dẫn Hàn Quốc Hynix vừa giới thiệu là thiết bị đầu tiên trên thế giới được chế tạo theo công nghệ 60 nm (nanomet). Kỹ thuật này cho phép giảm giá DRAM 1 Gb tới 50% so với công nghệ 80 nm.

Bộ nhớ nói trên sử dụng các công nghệ "transistor 3 chiều" và "kim loại 3 lớp", chạy nhanh, hỗ trợ truyền tải dữ liệu tốc độ mạnh và tăng cường công suất lưu trữ.

Quy trình sản xuất mới sẽ được triển khai đại trà vào nửa đầu năm tới và Hynix dự định tiếp tục nâng cấp để ứng dụng cho các linh kiện DRAM mật độ lưu trữ cao hơn trong tương lai, bên cạnh những sản phẩm hiệu suất cao như DRAM cho đồ họa và cho thiết bị di động.